

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-217503

(P2001-217503A)

(43) 公開日 平成13年8月10日 (2001.8.10)

(51) IntCl <sup>7</sup>	識別記号	F I	マークト (参考)
H01S 5/22		H01S 5/22	5 F 0 4 1
H01L 33/00		H01L 33/00	C 5 F 0 7 3

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全12頁)

(21) 出願番号 特願2000-25929(P2000-25929)

(22) 出願日 平成12年2月3日 (2000.2.3)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社  
大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 木戸 勲  
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72) 発明者 石橋 明彦  
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(74) 代理人 100097445  
弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 GaN系半導体発光素子およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 信頼性の高いGaN系半導体レーザを歩留まりよく作製する。

【解決手段】 基板の上にn-AlGaInクラッド層まで堆積した後、該n-AlGaInクラッド層をリッジ状に加工し、リッジ側面とリセス底部とをSiN<sub>2</sub>で被覆し、n-AlGaInクラッド層のC面を種結晶としてn-光ガイド層、活性層、p-光ガイド層、pクラッド層、p-GaN層を成長させて、GaN系半導体レーザを作製することで、信頼性の高い単一横モードのレーザを歩留まりよく作製できる。

